

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan KSCP  
Sidang Akademik 1997/98

April 1998

ZSC 545/4 - Spektroskopi Keadaan Pepejal

Masa: [3 jam]

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEBELAS** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **EMPAT** soalan sahaja: **DUA** dari Bahagian A dan **DUA** dari Bahagian B. Calon-calon boleh memilih menjawab Bahagian A dalam Bahasa Malaysia. Jika calon-calon memilih untuk menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya satu soalan wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia. Kesemua Bahagian B wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

Bahagian A

1. Lazimnya, medan elektrik  $\mathbf{E}$  dalam suatu gelombang optik merambat dalam arah  $z$  dalam bahantara bukan magnet isotrop dengan pemalar dielektrik  $\epsilon$  dapat ditulis sebagai:

$$\mathbf{E} = \text{Re}\{\mathbf{E}_0 e^{i(kz-\omega t)}\}$$

di mana  $\mathbf{E}_0 = (E_x, E_y)$  adalah vektor dua-dimensi dengan komponen kompleks  $E_x$  dan  $E_y$ .

- (a) Bagi kes khas  $E_y = 0$ , tunjukkan bagaimana amplitud dan fasa  $\mathbf{E}$  adalah terkandung dalam  $E_x$ .  
(10/100)
- (b) Takrifkan cahaya terkutub linear. Tuliskan, dengan alasan, bentuk-bentuk  $\mathbf{E}_0$  bagi
  - (i) pengkutuban linear dengan  $\mathbf{E}$  sepanjang  $x$ ,
  - (ii) pengkutuban linear dengan  $\mathbf{E}$  sepanjang  $y$ ,

...2/-

- (iii) pengkutuban linear dengan  $\mathbf{E}$  pada sudut  $\alpha$  terhadap paksi x.

(20/100)

- (c) Dalam suatu bahantara tak isotrop linear am, sifat-sifat dielektrik dinyatakan secara tensor pangkat-kedua  $\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_{ij}$ . Tunjukkan apakah maksud ini dengan menulis hubungan di antara vektor-vektor medan elektrik  $\mathbf{D}$  dan  $\mathbf{E}$

- (i) menggunakan tanda penjumlahan  
(ii) dengan penuh.

(10/100)

- (d) Tuliskan bentuk  $\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_{ij}$  merujuk kepada paksi-paksi utama bagi bahantara ekapaksi.

(10/100)

- (e) Bagi suatu gelombang satah dalam bahantara tak isotrop dengan  $\mathbf{E}$ , medan  $\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t)$   $\mathbf{k}$  dan  $\omega$  berkait melalui persamaan Fresnel  $(n^2 - \epsilon_1)(\epsilon_3 n_z^2 + \epsilon_1 n_x^2 - \epsilon_1 \epsilon_3) = 0$  di mana  $\mathbf{n} = ck/\omega$  dan  $\epsilon_{xx} = \epsilon_1$  dan  $\epsilon_{zz} = \epsilon_3$ . Gunakan persamaan ini untuk membincangkan dwirefringens bagi suatu bahantara ekapaksi dalam sebutan gelombang-gelombang biasa dan luar biasa.

(40/100)

2. (a) Cahaya terkutub linear adalah dituju secara normal dalam bahantara dengan pemalar dielektrik  $\epsilon_1$  di atas satah antaramuka dengan bahantara yang mempunyai pemalar dielektrik  $\epsilon_2$ . Dengan menulis amplitud-amplitud bagi gelombang tuju, terpantul dan dipancarkan sebagai  $E_0$ ,  $rE_0$  dan  $tE_0$ , buktikan dari persamaan Maxwell dan syarat sempadan bahawa:

$$r = \frac{\epsilon_1^{1/2} - \epsilon_2^{1/2}}{\epsilon_1^{1/2} + \epsilon_2^{1/2}} \quad t = \frac{2\epsilon_1^{1/2}}{\epsilon_1^{1/2} + \epsilon_2^{1/2}}$$

(30/100)

...3/-

- (b) Buktikan bahawa bila  $\varepsilon_1$  dan  $\varepsilon_2$  adalah kedua-duanya sahif dengan  $\varepsilon_1$  positif dan  $\varepsilon_2$  negatif  $|r| = 1$ .

(10/100)

- (c) Dalam hablur polar, fungsi dielektrik diberi oleh ungkapan

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 \left( 1 + \frac{\omega_L^2 - \omega_T^2}{\omega_T^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma} \right) \quad (2)$$

di mana  $\varepsilon_\infty > 1$  dan  $\omega_L > \omega_T$ . Lukis lakaran dengan penerangan, untuk menunjukkan pergantungan frekuensi bagi  $\varepsilon$  bila  $\Gamma = 0$ . Lukis lakaran bagi beberapa nilai nisbah  $\omega_L/\omega_T$  dan tandakan nilai-nilai frekuensi sifar dan frekuensi tinggi  $\varepsilon(0)$  dan  $\varepsilon(\omega \rightarrow \infty)$ .

(30/100)

- (d) Sinaran infra merah dituju secara normal dari vakum ke atas bahantara dengan fungsi dielektrik seperti persamaan bahagian (c). Gunakan ungkapan bagi  $r$  yang diterbitkan dalam bahagian (a) untuk melakarkan, dengan alasan-alasan, pergantungan frekuensi bagi keterpantulan  $|r|^2$  bila  $\Gamma = 0$ . Lukis lakaran seterusnya, dengan penerangan yang sesuai, untuk menunjukkan  $|r|^2$  bagi  $\Gamma$  bukan sifar.

(30/100)

3. (a) Kadar peralihan di antara keadaan  $\psi_i$  dekat atas jalur valens suatu semikonduktor dan kumpulan keadaan-keadaan akhir  $\psi_j$  dalam jalur konduksi diberi oleh aturan emas Fermi sebagai

$$v_{ij} = (2\pi/\hbar)\rho(j)|\int \psi_j^* H^i \psi_i d^3 r|^2$$

di mana  $\rho(j)$  adalah bilangan keadaan-keadaan  $j$  per unit julat tenaga. Dengan menganggap  $\psi_i \propto \exp[i(\vec{q}_v \cdot \vec{r} - \omega_v t)]$ ,  $\psi_j \propto \exp[i(\vec{q}_e \cdot \vec{r} - \omega_e t)]$  dan  $H^i \propto \exp[i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)]$  buktikan petua pemilihan  $\omega = \omega_e - \omega_v$  dan  $\vec{q} = \vec{q}_e - \vec{q}_v$ .

(20/100)

...4/-

- (b) Perturunkan dan jelaskan kenyataan bahawa peralihan optik adalah hampir menegak pada gambarajah struktur jalur. (10/100)
- (c) Jelaskan kepentingan perbezaan di antara semikonduktor-semikonduktor jurang langsung dengan tak langsung. (10/100)
- (d) Dengan menganggap ketumpatan keadaan-keadaan yang dibenarkan adalah seragam dalam ruang  $\vec{q}$  buktikan bahawa  $\rho(j) \propto E^{1/2}$  untuk suatu jalur konduksi parabolaan,  $E = \hbar^2 q^2 / 2m^*$ . Perturunkan pergantungan penyerapan tepi asas kepada tenaga foton  $\hbar\omega$  dalam suatu semikonduktor jurang langsung dan lakarkan bentuk pergantungan ini. (30/100)
- (e) Tepi penyerapan kemungkinan dirumitkan oleh corak-corak eksitonik. Tuliskan keterangan ringkas mengenai sifat-sifat eksiton dan cara bagaimana kesan-kesan eksitonik mengubahsuai tepi penyerapan asas. (30/100)

Bahagian B

4. (a) Dalam satu penyerakan Raman yang mana indeks biasan bagi cahaya tuju dan terserak adalah sama, tunjukkan bahawa pengujian tertib pertama mempunyai vektor gelombang  $\vec{q} \equiv 0$  merujuk kepada saiz zon Brillouin pertama. (25/100)
- (b) Kenapakah komponen cahaya terserak yang selalu diukur dalam ujian serakan cahaya Raman ialah komponen Stokes? (25/100)

- (c) Persamaan gerakan kekisi dengan kehadiran satu medan elektrik di dalam hablur dapat ditulis sebagai

$$\ddot{W}_\sigma + \omega_\sigma^2 W_\sigma = - \frac{NZ_\sigma(q.\xi_\sigma) \sum Z_\tau(q.\xi_\tau) W_\tau}{\epsilon_0 V (\epsilon_\infty^x q^x^2 + \epsilon_\infty^y q^y^2 + \epsilon_\infty^z q^z^2)}$$

dengan sebutan-sebutan mempunyai maksud biasa seperti di dalam nota.

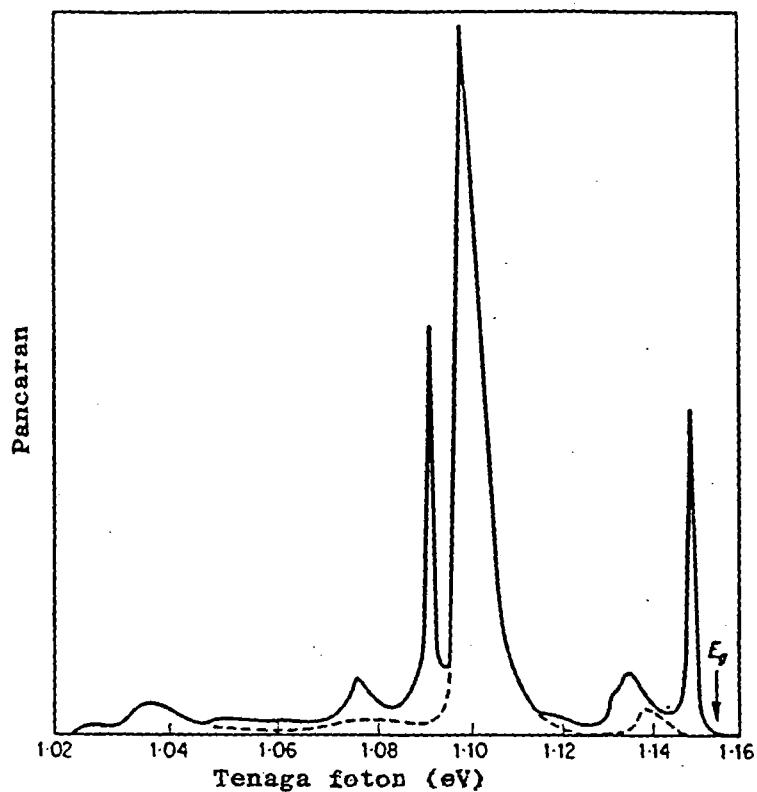
- (i) Tunjukkan bagaimana persamaan di atas dapat menerangkan ciri-ciri mod tak polar dan melintang.
- (ii) Tunjukkan bagi hablur GaAs bahawa persamaan gerakan mod membujurnya dapat diberi sebagai

$$\ddot{W} + \omega_T^2 W = - \frac{NZ^2 W}{\epsilon_0 V \epsilon_\infty}$$

dengan  $\omega_T$  ialah frekuensi bagi mod melintang.

- (iii) Daripada persamaan bahagian (ii), tentukan persamaan bagi frekuensi mod membujur tersebut.  
(50/100)

5. (a) Rajah di bawah mewakili spektrum pancaran daripada Si yang diuja secara optik pada suhu 25°K. Lengkung putus mewakili Si tulen sementara lengkung penuh mewakili Si yang didop dengan  $8 \times 10^{16}$  bendasing As se cc. Daripada J.R. Haynes, Phys. Rev. Lett., 4, 361 (1960).



Perihalkan dengan jelas proses-proses pancaran foton bagi spektrum pancaran tersebut.

(30/100)

- (b) Bincangkan peranan bendasing Cu, Al, I dan In di dalam spektrum fotoluminesens ZnS apabila diuja dengan cahaya ultra lembayung.

(20/100)

...7/-

- (c) (i) Terbitkan keamatan pancaran termoluminesens kinetik molekul (Tertib Pertama)

$$I = n_{t_0} s \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \exp\left\{-\int_{T_0}^T \frac{s}{\beta} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dT\right\}$$

dengan  $n_{t_0}$  ialah bilangan elektron yang terperangkap pada suhu  $T_0$ ,  
 $s$  ialah pekali kebarangkalian lepasan,  
 $E$  ialah kedalaman paras perangkap di bahagian bawah jalur konduksi dan  
 $\beta = \frac{dT}{dt}$  ialah kadar pemanasan malar.

- (ii) Bincangkan kelakuan persamaan di atas pada suhu rendah, pertengahan dan tinggi.

- (iii) Terbitkan persamaan bagi kedalaman perangkap  $E$  menerusi syarat bagi keamatan maksimum.

(50/100)

TRANSLATION

Section A

1. By convention, the electric field  $\mathbf{E}$  in an optical wave propagating in the  $z$  direction in an isotropic non-magnetic medium with dielectric constant  $\epsilon$  is written as

$$\mathbf{E} = \operatorname{Re}\{\mathbf{E}_0 e^{i(kz-\omega t)}\}$$

where  $\mathbf{E}_0 = (E_x, E_y)$  is a two-dimensional vector with complex components  $E_x$  and  $E_y$ .

- (a) For the special case  $E_y = 0$ , show how the amplitude and phase of  $\mathbf{E}$  are contained in  $E_x$ . (10/100)
- (b) Define linearly polarized light. Write down, with reasons, the forms of  $\mathbf{E}_0$  for
- (i) linear polarization with  $\mathbf{E}$  along  $x$ ,
  - (ii) linear polarization with  $\mathbf{E}$  along  $y$ ,
  - (iii) linear polarization with  $\mathbf{E}$  at angle  $\alpha$  to the  $x$  axis.
- (20/100)
- (c) In a general linear anisotropic medium the dielectric properties are expressed by means of a second-rank tensor  $\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_{ij}$ . Show what this means by writing down the relation between the electric field vectors  $\mathbf{D}$  and  $\mathbf{E}$
- (i) using the summation convention and
  - (ii) in full.
- (10/100)
- (d) Write down the form of  $\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_{ij}$  referred to the principal axes of a uniaxial medium. (10/100)

- (e) For a plane wave in an anisotropic medium with  $\mathbf{E}$  field  $\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t)$   $\mathbf{k}$  and  $\omega$  are related by the Fresnel equation  $(n^2 - \epsilon_1)(\epsilon_3 n_z^2 + \epsilon_1 n_x^2 - \epsilon_1 \epsilon_3) = 0$  where  $\mathbf{n} = c\mathbf{k}/\omega$  and  $\epsilon_{xx} = \epsilon_1$  and  $\epsilon_{zz} = \epsilon_3$ . Use this equation to discuss the birefringence of a uniaxial medium in terms of ordinary and extraordinary waves.

(40/100)

2. (a) Linearly polarized light is normally incident in a medium with dielectric constant  $\epsilon_1$  on a plane interface with a medium of dielectric constant  $\epsilon_2$ . Writing the amplitudes of the incident, reflected and transmitted waves as  $E_0$ ,  $rE_0$  and  $tE_0$  prove from Maxwell's equations and boundary conditions that

$$r = \frac{\epsilon_1^{1/2} - \epsilon_2^{1/2}}{\epsilon_1^{1/2} + \epsilon_2^{1/2}} \quad t = \frac{2\epsilon_1^{1/2}}{\epsilon_1^{1/2} + \epsilon_2^{1/2}}$$

(30/100)

- (b) Prove that when  $\epsilon_1$  and  $\epsilon_2$  are both real with  $\epsilon_1$  positive and  $\epsilon_2$  negative  $|r| = 1$ .

(10/100)

- (c) In a polar crystal the dielectric function is given by the expression

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left( 1 + \frac{\omega_L^2 - \omega_T^2}{\omega_T^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma} \right) \quad (2)$$

where  $\epsilon_\infty > 1$  and  $\omega_L > \omega_T$ . Draw sketches, with explanations, to show the frequency dependence of  $\epsilon$  when  $\Gamma = 0$ . Draw sketches for several values of the ratio  $\omega_L/\omega_T$  and mark the zero frequency and high frequency values  $\epsilon(0)$  and  $\epsilon(\omega \rightarrow \infty)$ .

(30/100)

...10/-

- (d) Infrared radiation is normally incident from vacuum on a medium with dielectric function given by eqn. (2). Use the expression for  $r$  derived in (a) to sketch, with reasons, the frequency dependence of the reflectivity  $|r|^2$  when  $\Gamma = 0$ . Draw further sketches, with suitable explanation, to show  $|r|^2$  for non-zero  $\Gamma$ .

(30/100)

3. (a) The transition rate between a state  $\psi_i$  near the top of the valence band of a semiconductor and a group of final states  $\psi_j$  in the conduction band is given by Fermi's gold rule as

$$v_{ij} = (2\pi/\hbar)\rho(j)|\int \psi_j^* H^1 \psi_i d^3 r|^2$$

where  $\rho(j)$  is the number of states  $j$  per unit energy range.

Assuming that  $\psi_i \propto \exp[i(\vec{q}_v \cdot \vec{r} - \omega_v t)]$ ,  $\psi_j \propto \exp[i(\vec{q}_c \cdot \vec{r} - \omega_c t)]$

and  $H^1 \propto \exp[i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)]$  prove the selection rules  $\omega = \omega_c - \omega_v$

and  $\vec{q} = \vec{q}_c - \vec{q}_v$ .

(20/100)

- (b) Deduce and explain the statement that optical transitions are nearly vertical on band-structure diagrams.

(10/100)

- (c) Explain the importance of the distinction between direct and indirect gap semiconductors.

(10/100)

- (d) Assuming that the density of allowed states is uniform in  $\vec{q}$  space prove that  $\rho(j) \propto E^{1/2}$  for a parabolic conduction band,  $E = \hbar^2 q^2 / 2m^*$ . Deduce the dependence on photon energy  $\hbar\omega$  of the fundamental absorption edge in a direct-gap semiconductor and sketch the form of this dependence.

(30/100)

- (e) The absorption edge may be complicated by excitonic features. Write a short account of the properties of excitons and of the way in which excitonic effects modify the fundamental absorption edge.

(30/100)

- 0000000 -